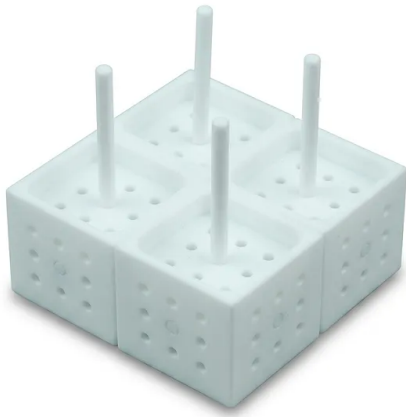


定制化Ptfе晶圆清洗花篮 耐化学腐蚀氟聚合物载具 适用于半导体蚀刻与新能源加工

货号: PL-CP149



简介

通过定制化PTFE晶圆清洗花篮优化您的半导体和新能源制造工艺。专为蚀刻和RCA清洗过程中的极端耐化学腐蚀性而设计，这些高纯度氟聚合物载具确保了在严苛工业环境下的工艺完整性和长期耐用性。

[了解更多](#)

应用领域	描述	主要优势
半导体RCA清洗	使用SC-1和SC-2溶液对硅片进行顺序清洗，以去除有机和金属污染物。	零污染，耐受氨水/过氧化物混合物。
氢氟酸（HF）蚀刻	去除原生氧化物或对晶圆表面的二氧化硅层进行受控蚀刻。	对HF具有绝对耐受性，而HF会溶解玻璃或石英替代品。
光伏制绒	对单晶或多晶硅片进行湿法化学蚀刻，以形成陷光表面。	一致的槽口对准确保大批量的均匀制绒。
食人鱼溶液处理	使用硫酸和过氧化氢强力去除有机残留物和光刻胶。	耐受极端放热反应和高温酸性环境。
化学机械抛光后漂洗	化学机械抛光后对晶片进行关键清洗，以去除研磨浆料。	光滑的表面和高排水性防止颗粒再沉积。
化合物半导体制备	用于先进电子和光电器件制造的GaAs或InP晶片的专门清洗。	可针对非标准晶片厚度和尺寸定制槽口几何形状。
微通道反应器装载	在定制化反应室内定位基板，用于受控化学气相或液相沉积。	量身定制的尺寸可完美适配定制实验室装置。
光刻显影	在微细加工流程中，在光刻胶层的显影和剥离过程中固定基板。	耐溶剂性确保载具在工艺过程中不会降解或释放气体。

参数	PL-CP149规格详情
型号标识	PL-CP149系列
材料结构	100%原生高纯度PTFE（聚四氟乙烯）
制造方法	全定制CNC加工
化学兼容性	通用（酸、碱、溶剂、氧化剂、HF）
工作温度范围	-200°C 至 +260°C (-328°F 至 +500°F)
晶圆兼容性	可定制适用于2英寸、3英寸、4英寸、6英寸、8英寸、12英寸或非标准尺寸
槽口配置	完全可定制（可变间距、宽度和深度）
槽口数量	根据客户要求定义（例如，容量10、25、50）
手柄设计	集成式、可拆卸式或加长式（长度可定制）
表面光洁度	光滑、低孔隙率的机加工表面
纯度标准	适用于痕量分析和10级/100级洁净室使用
排水特性	可定制的底部/侧面排水口